第4章 存储子系统

- -半导体
- -磁表面
- -光存储

-虚拟存储技术

原理及器件

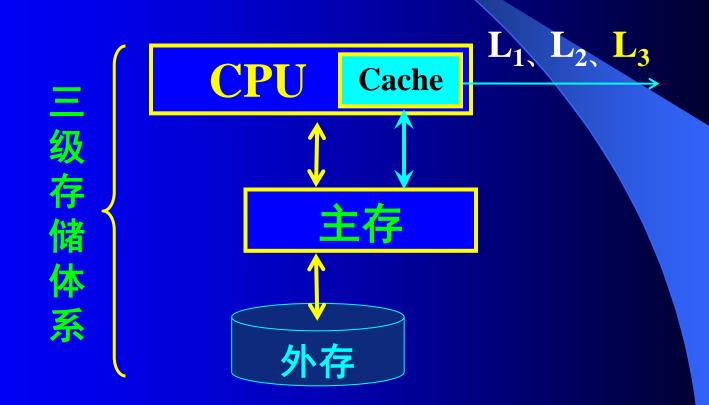
1/1/

本章需解决的主要问题:

- (1) 存储器如何存储信息?
- (2) 在实际应用中如何用存储芯片组成具有
- 一定容量的存储器?
 - (3) 如何改进存储系统的性能?

4.1 概述

1. 存储系统的层次结构



(1) 主存(内存)

主要存放CPU当前使用的指令和数据。

能随机访问 工作速度快 有足够的存储容量

(2) 辅存(外存)

存放大量的后备程序和数据

速度较慢

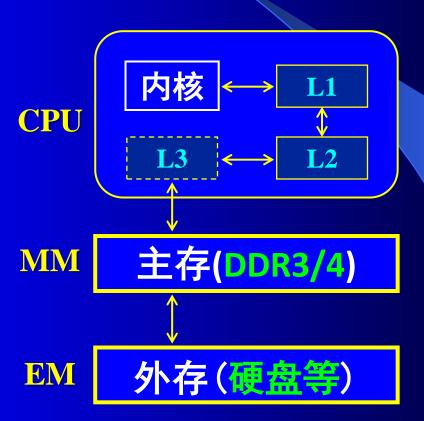
容量较大

(3) 高速缓冲存储器(Cache)

存放CPU在当前一小段时间内多次使用的程序和数据,以缓解CPU和主存的速度差异。

速度非常快

容量却很小



2. 物理存储器与虚拟存储器

物理存储器:

物理形态上真实存在的存储器,简称为实存,其地址称为物理地址或实地址。

虚拟存储器:

虚拟存储器是一个逻辑模型,并非物理存在,基于物理存储器并靠硬件+操作系统的映射来实现。



逻辑上能提供比物理存储器更大的虚拟存储空间,相关地址称为虚地址或逻辑地址。

3. 存储器的分类(按存储介质)

(1) 半导体存储器

静态存储器:利用双稳态触发器的两个稳定状态存储信息,信息易失

动态存储器:依靠电容上的电荷暂存信息,主存

(2) 磁表面存储器

利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息,容量大,非破坏性读出,长期保存信息,速度慢,外存

例如: IDE硬盘, SATA硬盘

(3) 光盘存储器

利用光斑的有无/晶相等变化表示信息,容量很大,非破坏性读出,长期保存信息,速度慢,外存

- ※只读型光盘CD-ROM
- ※一次写入型光盘WORM
- ※可擦除/重写型光盘

3. 存储器的分类(按存取方式)

(1) 随机存取存储器(RAM, ROM)

随机存取:

按地址访问存储器中的任一单元,访问时间与存储单元的地址无关。

RAM

例如,主存

ROM

例如, 微程序控制器中的控制存储器(CM)

RAM:可读可写 如: SDR/DDR/DDR2-4

ROM: 只读型

固化型:用户不能写入数据

PROM: 用户可写入一次

EPROM:可多次编程(紫外线擦除)

EEPROM:可多次写入(电擦除)

FLASH Memory(闪存)

按处

速度指标:频率-存取周期或读/写周期(ns)

通常用作主存、高速缓存。

(2) 顺序存取存储器(SAM)

访问时读/写部件按顺序查找目标地址,访问时间与数据的存储位置有关。

例如:磁带机(录音机)、电影胶片。

两步操作

定位操作

数据读/写操作

速度指标

平均定位时间(ms)

数据传输率(b/s)

(3) 直接存取存储器(DAM)

访问时读/写部件先粗定位一个小区域,再在该区 域内顺序查找。

访问时间与数据位置有关,例如:硬盘。

「定位(寻道)操作 三步操作〈等待(旋转)操作 し读/写操作

~ 平均定位(平均寻道) 时间(ms) 速度指标〈平均等待(平均旋转)时间(ms) 数据传输率(b/s)

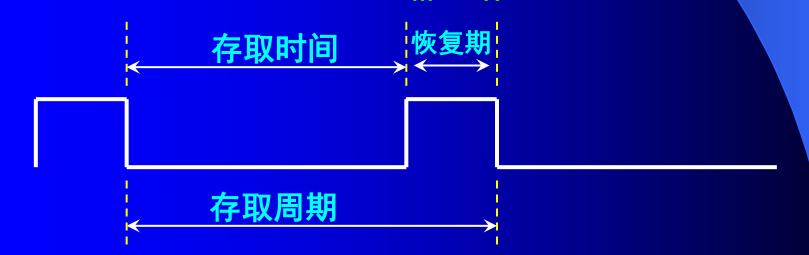
4. 存储器的技术指标

(1)存取时间

从存储器收到读写命令,到存储器读出(写入)信息 所需要的时间,T_A

(2) 存取周期

存储器做连续访问操作过程中一次完整的存取操作所需的总时间, T_M (通常 $T_M > T_A$)



(2)数据传输率-R

单位时间内存取信息的数据量,也叫带宽或频宽

【例】某双通道DDR-4内存传输频率为3200MHz,位 宽64比特,则其有效带宽为:

$$R_{DDR-4} = (64b \times 3200 MHz \div 8) \times 2$$

= 51.2GBps